

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年10月7日(07.10.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/199869 A1

(51) 国際特許分類:
G09F 9/30 (2006.01) *H01L 51/50* (2006.01)
H01L 27/32 (2006.01)

PATENT ATTORNEYS, INC.); 〒1440052 東京都大田区蒲田 5-24-2 損保ジャパン日本興亜蒲田ビル9階 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/008200

(22) 国際出願日: 2021年3月3日(03.03.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-065831 2020年4月1日(01.04.2020) JP

(71) 出願人:株式会社ジャパンディスプレイ(JAPAN DISPLAY INC.) [JP/JP]; 〒1050003 東京都港区西新橋三丁目7番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者:坂本 亜沙美(SAKAMOTO Asami); 〒1050003 東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会社ジャパンディスプレイ内 Tokyo (JP).

(74) 代理人:特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ(TAKAHASHI, HAYASHI AND PARTNER

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

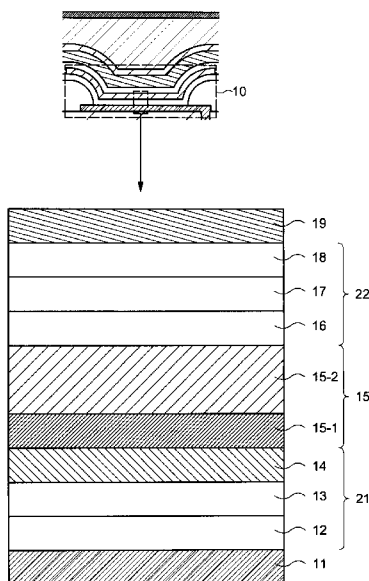
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) Title: LIGHT-EMITTING ELEMENT AND DISPLAY DEVICE

(54) 発明の名称: 発光素子および表示装置

(57) Abstract: A light-emitting element according to the present invention includes a pair of electrodes, a first organic layer, and a second organic layer adjacent to the first organic layer, the first and second organic layers being located between the pair of electrodes. The first organic layer includes a first organic material. The second organic layer includes a second organic material. The second organic layer includes a first region and a second region. The first region is in contact with the first organic layer and includes the first organic material. The first organic material has higher hole transportability than electron transportability. The absolute value of the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) level of the first organic layer is smaller than the absolute value of the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) level of the second organic layer.

(57) 要約: 発光素子は、一对の電極と、一对の電極の間に、第1有機層および第1有機層に隣接する第2有機層と、を含み、第1有機層は、第1有機材料を含み、第2有機層は、第2有機材料を含み、第2有機層は、第1領域および第2領域を含み、第1領域は、第1有機層と接し、第1有機材料を含む。第1有機材料は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高く、第1有機層の最低空軌道(LUMO)準位の絶対値は、第2有機層の最低空軌道(LUMO)準位の絶対値よりも小さい。



DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

- 一 国際調査報告（条約第21条(3)）

明 細 書

発明の名称：発光素子および表示装置

技術分野

[0001] 本発明の一実施形態は、発光素子および発光素子を含む表示装置に関する。

背景技術

[0002] 表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス材料（有機ＥＬ材料）を表示領域の発光素子（有機ＥＬ素子）に用いた有機ＥＬ表示装置（Organic Electroluminescence Display）が知られている。有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ材料を発光させることにより表示を実現する、いわゆる自発光型の表示装置である。

[0003] 有機ＥＬ表示装置は、基板上に形成された複数の画素の各々に、表示素子として電界発光素子（以下、発光素子という）を有している。発光素子は、一対の電極間に、電界発光性を示す有機化合物を含む層（以下、発光層）を有している。一対の電極間に電流を供給することで、これらの電極から発光層へキャリア（正孔および電子）が注入されると正孔と電子は、発光層内で再結合して励起状態となる。励起状態が基底状態に緩和する過程のエネルギーが発光として取り出されることによって表示装置としての機能が発現される。

[0004] 高輝度の有機ＥＬ表示装置の発光素子として、発光層に隣接して正孔ブロック層もしくは電子ブロック層を設けた素子構造または発光層に隣接した正孔ブロック層および電子ブロック層で挟まれた素子構造が知られている（例えば、特許文献１参照。）。特許文献１によれば、発光層に隣接する正孔ブロック層または電子ブロック層によって、正孔および電子を発光層中に効果的に閉じ込めることができるため、発光効率の高い発光素子が得られる。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特開2000-196140号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] しかしながら、発光層に隣接して正孔ブロック層または電子ブロック層を設けた場合、発光層と正孔ブロック層との界面または発光層と電子ブロック層との界面にキャリアが蓄積しすぎるため、界面において発光に寄与しない酸化反応または還元反応が起きることがあった。そのため、発光素子の発光効率向上のもの、酸化反応または還元反応が起きる結果、発光素子の信頼性を十分に確保することが難しかった。

[0007] 本発明は、上記問題に鑑み、信頼性が改善された発光素子および表示装置を提供することを課題の一つとする。

課題を解決するための手段

[0008] 本発明の一実施形態に係る発光素子は、一対の電極と、一対の電極の間に、第1有機層および第1有機層に隣接する第2有機層と、を含み、第1有機層は、第1有機材料を含み、第2有機層は、第2有機材料を含み、第2有機層は、第1領域および第2領域を含み、第1領域は、第1有機層と接し、第1有機材料を含む。

図面の簡単な説明

[0009] [図1]本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

[図2]本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

[図3]本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

[図4]本発明の一実施形態に係る発光素子の模式的断面図である。

[図5]本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す平面図である。

[図6]本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。

[図7]本発明の一実施形態に係る表示装置の表示領域にマトリクス状に配列された複数の画素のレイアウトを示す平面図である。

[図8]本発明の一実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。

発明を実施するための形態

[0010] 以下、本発明の各実施形態において、図面等を参照しつつ説明する。但し、本発明は、その技術的思想の要旨を逸脱しない範囲において様々な態様で実施することができ、以下に例示する実施形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

[0011] 図面は、説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、図示の形状そのものが本発明の解釈を限定するものではない。また、図面において、明細書中で既出の図に関して説明したものと同様の機能を備えた要素には、別図であっても同一の符号を付して、重複する説明を省略する場合がある。

[0012] ある一つの膜を加工して複数の構造体を形成した場合、各々の構造体は異なる機能、役割を有する場合があり、また各々の構造体はそれが形成される下地が異なる場合がある。しかしながら、これら複数の構造体は、同一の工程で同一層として形成された膜に由来するものであり、同一の材料を有する。従って、これら複数の膜は同一層に存在しているものと定義する。

[0013] ある構造体の上に他の構造体を配置する態様を表現するにあたり、単に「上に」と表記する場合、特に断りの無い限りは、ある構造体に接して、直上に他の構造体を配置する場合と、ある構造体の上方に、さらに別の構造体を介して他の構造体を配置する場合との両方を含むものとする。

[0014] 「ある構造体が他の構造体から露出する」という表現は、ある構造体の一部が他の構造体によって覆われていない領域を意味する。ただしこの他の構造体によって覆われていない部分が、さらに別の構造体によって覆われている場合も含む。

[0015] <第1実施形態>

本発明の一実施形態に係る発光素子10の構成について、図1を参照して説明する。

[0016] 図1は、本発明の一実施形態に係る発光素子10の模式的断面図である。

具体的には、図 1 は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子 10 の一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

[0017] 発光素子 10 は、一对の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）と、第 1 有機層 14 と、第 2 有機層 15 と、を含む。第 1 有機層 14 および第 2 有機層 15 は、一对の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）の間に設けられている。第 2 有機層 15 は、第 1 有機層 14 に隣接して設けられている。第 2 有機層 15 は、第 1 領域 15-1 および第 2 領域 15-2 を含み、第 1 領域 15-1 は、第 1 有機層 14 に接している。また、発光素子 10 は、一对の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）の間に、さらに、第 2 有機層 15 に隣接する第 3 有機層 16 を含む。第 2 領域 15-2 は、第 3 有機層 16 に接している。

[0018] 例えば、第 1 電極 11 は陽極であり、第 1 有機層 14 は電子ブロック層であり、第 2 有機層 15 は発光層であり、第 3 有機層 16 は正孔ブロック層であり、第 2 電極 19 は陰極である。この場合、図 1 に示すように、発光素子 10 は、第 1 電極 11（陽極）と、正孔注入層 12 と、正孔輸送層 13 と、第 1 有機層 14（電子ブロック層）と、第 2 有機層 15（発光層）と、第 3 有機層 16（正孔ブロック層）と、電子輸送層 17 と、電子注入層 18 と、第 2 電極 19（陰極）と、を含むことができる。但し、発光素子 10 の構成はこれに限られない。正孔注入層 12、正孔輸送層 13、電子輸送層 17、または電子注入層 18 は、必要に応じて設けることができる。

[0019] また、例えば、第 1 電極 11 は陰極であり、第 1 有機層 14 は正孔ブロック層であり、第 2 有機層 15 は発光層であり、第 3 有機層 16 は電子ブロック層であり、第 2 電極 19 は陽極である。この場合においても、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、または電子注入層 18 を必要に応じて設けることができる。

[0020] 以下では、本実施形態を理解しやすく説明するため、第 1 電極 11、第 1 有機層 14、第 2 有機層 15、第 3 有機層 16、および第 2 電極 19 が、それぞれ、陽極、電子ブロック層、発光層、正孔ブロック層、および陰極であ

るとして説明する。また、以下では、第1電極11と第2有機層15との間の層を第1機能層21とし、第2有機層15と第2電極19との間の層を第2機能層22として説明する場合がある。

[0021] [電子ブロック層]

第1有機層14は、電子ブロック層として機能することができる。すなわち、第1有機層14は、第2電極19から第2機能層22に注入された電子が再結合に寄与することなく第2有機層15を通過して正孔輸送層13へ注入されることを防ぐことができる。言い換えると、第1有機層14は、第2有機層15中に電子を閉じ込めるとともに、第2有機層15で得られる再結合の励起エネルギーが正孔輸送層13にエネルギー移動することを防ぐことができる。したがって、第1有機層14は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高いことが好ましい。また、第1有機層14の最低空軌道(LUMO)準位の絶対値は、第2有機層15の最低空軌道(LUMO)準位の絶対値よりも小さいことが好ましい。具体的には、第1有機層14のLUMO準位と第2有機層15のLUMO準位との差の絶対値は、0.2 eV以上であり、好ましくは0.3 eV以上であり、さらに好ましくは0.5 eV以上である。

[0022] また、第1有機層14のバンドギャップは、第2有機層15のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。

[0023] 第1有機層14は、第1有機材料を含む。第1有機材料は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高い材料である。第1有機材料は、例えば、共役系の比較的小さいカルバゾール誘導体、アリールアミン誘導体、またはチオフェン誘導体などを用いることができる。

[0024] [発光層]

第2有機層15は、発光層として機能することができる。すなわち、第2有機層15は、正孔と電子が再結合する層である。第2有機層15は、ホスト-ゲスト型の構成を有する。すなわち、第2有機層15は、ホストである第2有機材料に、ゲストである発光材料が含まれている。第2有機材料としては、例えば、スチルベン誘導体もしくはアントラセン誘導体などの縮合芳

香族化合物、カルバゾール誘導体、キノリノール配位子を含む金属錯体、芳香族アミン、またはフェナントロリン誘導体などの含窒素ヘテロ芳香族化合物などを用いることができる。発光材料としては、例えば、クマリン誘導体、ピラン誘導体、キノクリドン誘導体、テトラセン誘導体、ピレン誘導体、もしくはアントラセン誘導体などの蛍光材料、またはイリジウム系オルトメタル錯体などの燐光材料を用いることができる。第2有機層15は、第2有機材料のバンドギャップが発光材料のバンドギャップよりも大きくなるように構成される。

[0025] 本実施形態に係る発光素子10の第2有機層15は、さらに、第1有機材料を含む。第2有機層15に、電子輸送性よりも正孔輸送性が高い第1有機材料を添加することで、第2有機層15の正孔輸送性を向上させることができる。言い換えると、第1有機材料を用いて、第2有機層15の正孔輸送性と電子輸送性を調整することができる（キャリアバランスの調整）。

[0026] 一般的に、第2有機層15の第2有機材料は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高い。そのため、第2有機層15中のキャリアは正孔よりも電子が優位となり、電子は第1有機層14と第2有機層15との界面に蓄積しやすい。この場合、発光領域は界面近傍であるが、界面での電子密度が高くなることで濃度消光が起きやすい。すなわち、発光に寄与しないキャリアが増加する結果、表示素子の電流効率が低下する。

[0027] 一方、第2有機層15に第1有機材料が添加されると、第2有機層15の正孔輸送性が高くなる。第2有機層15中において電子と再結合する正孔が増加するため、結果として、第1有機層14と第2有機層15との界面に到達する電子を減少させることができる。したがって、発光領域が第2有機層15全体に広がるため、発光素子10の電流効率が向上する。

[0028] また、第2有機層15は、第1領域15-1と、第2領域15-2と、を含む。第1領域15-1は、第1有機層14と接する。第2領域15-2は、第1有機層14から離れている。

[0029] 第1領域15-1と第2領域15-2とは、第1有機材料の濃度が異なる

。第1領域15-1における第1有機材料の濃度は、第2領域15-2における第1有機材料の濃度よりも大きいことが好ましい。例えば、第1領域15-1における第1有機材料の濃度は、20重量%以下であり、好ましくは15重量%以下であり、さらに好ましくは10重量%以下である。また、第2領域15-2における第1有機材料の濃度は、第1領域15-1における第1有機材料の濃度よりも小さく、15重量%以下であり、好ましくは10重量%以下であり、さらに好ましくは5重量%以下である。第2領域15-2における第1有機材料の濃度が高いと、第3有機層16と第2有機層15との界面に正孔が蓄積してしまう。そのため、第1領域15-1および第2領域15-2の各々における第1有機材料の濃度を上記範囲とし、第1領域15-1および第2領域15-2の正孔輸送性が調整されることが好ましい。

[0030] また、第1領域15-1と第2領域15-2とは、膜厚が異なってもよい。第1領域15-1の膜厚は、第2領域15-2の膜厚よりも小さいことが好ましい。例えば、第1領域15-1の膜厚は、第2有機層15の膜厚の0%よりも大きく、かつ、40%以下であり、好ましくは30%以下であり、さらに好ましくは20%である。第1領域15-1の膜厚を上記範囲にすることでも、第2有機層15の正孔輸送性を調整することができる。

[0031] 第2有機層15を第1領域15-1と第2領域15-2とに分けることで、キャリアバランスを調整するだけでなく、発光領域の位置も調整することができる。すなわち、発光領域を、第1有機層14と第2有機層15との界面から遠ざけることができる。そのため、界面における化学反応が抑制され、発光素子10の信頼性が向上する。

[0032] [正孔ブロック層]

第3有機層16は、正孔ブロック層として機能することができる。すなわち、第3有機層16は、第1電極11から第1機能層21に注入された正孔が再結合に寄与することなく第2有機層15を通過して第3有機層16へ注入されることを防ぐことができる。言い換えると、第3有機層16は、第2

有機層 15 中に正孔を閉じ込めるとともに、第 2 有機層 15 で得られる再結合の励起エネルギーが電子輸送層 17 にエネルギー移動することを防ぐことができる。したがって、第 3 有機層 16 は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高いことが好ましい。また、第 3 有機層 16 の最高被占軌道 (HOMO) 準位の絶対値は、第 2 有機層 15 の最高被占軌道 (HOMO) 準位の絶対値よりも大きいことが好ましい。具体的には、第 3 有機層 16 の HOMO 準位と第 2 有機層 15 の HOMO 準位との差の絶対値は、 0.2 eV 以上であり、好ましくは 0.3 eV 以上であり、さらに好ましくは 0.5 eV 以上である。

[0033] また、第 3 有機層 16 のバンドギャップは、第 2 有機層 15 のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。

[0034] 第 3 有機層 16 は、第 3 有機材料を含む。第 3 有機材料は、例えば、フェナントロリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、またはビス (2-メチルー 8-キノリノラト) (4-ヒドロキシ-ビフェニル) アルミニウムなどを用いることができる。

[0035] [陽極および陰極]

第 1 電極 11 は、陽極として機能することができる。すなわち、第 1 電極 11 は、第 1 機能層 21 に正孔を注入することができる。そのため、第 1 電極 11 は、仕事関数の大きい材料を用いることが好ましい。

[0036] 第 2 電極 19 は、陰極として機能することができる。すなわち、第 2 電極 19 は、第 2 機能層 22 に電子を供給することができる。そのため、第 2 電極 19 は、仕事関数の小さい材料を用いることが好ましい。

[0037] 第 1 電極 11 および第 2 電極 19 の少なくとも一方は、第 2 有機層 15 からの光が透過することができる透明導電材料を用いる。透明導電材料としては、例えば、酸化インジウムスズ (ITO)、酸化インジウム亜鉛 (IZO)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化アルミニウム亜鉛 (AZO)、酸化ガリウム亜鉛 (GZO)、または酸化アルミニウム亜鉛 (AZO) などを用いることができる。また、透明導電材料の抵抗が高い場合、数 nm 程度の金属薄膜を

透明導電材料で挟み込んだ積層体を第1電極11または第2電極19とすることもできる。金属薄膜の材料としては、例えば、金（Au）、銀（Ag）、銅（Cu）、アルミニウム（Al）、タングステン（W）、モリブデン（Mo）、もしくは亜鉛（Zn）、またはこれらの合金などを用いることができる。

[0038] 一方、第2有機層15からの光を反射させる場合、第1電極11または第2電極は、金属材料を用いることができる。金属材料としては、例えば、金（Au）、銀（Ag）、銅（Cu）、アルミニウム（Al）、タングステン（W）、モリブデン（Mo）、もしくは亜鉛（Zn）、またはこれらの合金などを用いることができる。

[0039] [正孔注入層]

正孔注入層12は、第1電極11から第1機能層21へ正孔を注入しやすくする機能を有する。正孔注入層12は、酸化されやすい化合物（電子供与性化合物）、すなわち、最高被占軌道（HOMO）準位の絶対値の小さい化合物を用いることができる。正孔注入層12の材料として、例えば、ベンジジン誘導体もしくはトリアリールアミンなどの芳香族アミン、カルバゾール誘導体、チオフェン誘導体、または銅フタロシアニンなどのフタロシアニン誘導体などを用いることができる。また、正孔注入層12の材料として、例えば、ポリチオフェンまたはポリアニリン誘導体などを用いることもできる。さらに、正孔注入層12の材料として、例えば、芳香族アミン、カルバゾール誘導体、または芳香族炭化水素などの電子供与性化合物と電子受容体との混合物を用いてもよい。電子受容体としては、例えば、酸化バナジウムもしくは酸化モリブデンなどの遷移金属酸化物、含窒素ヘテロ芳香族化合物、またはシアノ基などの強い電子吸引基を有するヘテロ芳香族化合物などを用いることができる。これらの材料または混合物はイオン化ポテンシャルが小さいため、第1電極11からの正孔注入障壁が小さい。そのため、正孔注入層12は、発光素子10の駆動電圧の低減に寄与する。

[0040] [正孔輸送層]

正孔輸送層 13 は、第 1 電極 11 から正孔注入層 12 に注入された正孔を第 2 有機層 15 へ輸送する機能を有する。正孔輸送層 13 は、正孔注入層 12 で使用可能な材料と同様または類似する材料を用いることができる。正孔輸送層 13 の HOMO 準位の絶対値は、正孔注入層 12 の HOMO 準位の絶対値よりも小さいことが好ましいが、その差は小さいことが好ましい。すなわち、正孔輸送層 13 の HOMO 準位と正孔注入層 12 の HOMO 準位との差は、0.5 eV 以下であり、好ましくは 0.3 eV 以下であり、さらに好ましくはそれ以下である。上述した材料は電子輸送性よりもホール輸送性が高いため、正孔を効率よく第 2 有機層 15 へ輸送することができ、発光素子 10 の低い駆動電圧を実現することができる。

[0041] [電子輸送層]

電子輸送層 17 は第 2 電極 19 から電子注入層 18 に注入された電子を第 2 有機層 15 へ輸送する機能を有する。電子輸送層 17 は、正孔輸送性よりも電子輸送性の高い化合物を用いることができる。電子輸送層 17 の材料として、例えば、8-キノリノールを基本骨格として有する配位子を含む金属錯体、オキサジアゾール誘導体もしくはトリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体などの窒素含有ヘテロ芳香族化合物、シラシクロペンタジエン誘導体、アントラセン誘導体、ピレン誘導体、またはペリレン誘導体などの芳香族炭化水素などを用いることができる。金属錯体としては、例えば、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(AIq)や(8-キノリノラト)リチウムなどを用いることができる。

[0042] [電子注入層]

電子注入層 18 は、第 2 電極 19 から第 2 機能層 22 へ電子を注入しやすくする機能を有する。電子注入層 18 の材料として、例えば、フッ化カルシウムもしくはフッ化リチウムなどの金属フッ化物、リチウム、カルシウム、またはマグネシウムなどの第 1 族金属または第 2 族元素を用いることができる。また、電子注入層 18 として、電子輸送層 17 に使用可能な材料と電子供与体との混合物を用いてもよい。電子供与体としては、例えば、第 1 族金

属もしくは第2族元素、またはイッテルビウムなどのランタノイド金属などを用いることができる。

[0043] <具体例>

陽極、正孔注入層、正孔輸送層、電子ブロック層、発光層、正孔ブロック層、電子輸送層、電子注入層、および陰極の積層構造を有する典型的な表示素子を作製した。素子1は、発光層を単層とし、発光層は、第2有機材料と発光材料のみからなる素子である。素子2は、発光層を単層とし、発光層は、第2有機材料と発光材料に加えて、第2有機材料に対して電子ブロック層の材料である第1有機材料を10重量%添加した素子である。素子3は、発光層を2つの領域（第1領域および第2領域）とし、電子ブロック層と接する第1領域は、第2有機材料と発光材料に加えて、第2有機材料に対して第1有機材料を10重量%添加し、電子ブロック層から離れた第2領域は、第2有機材料と発光材料に加えて、第2有機材料に対して第1有機材料を5重量%添加した素子である。

[0044] 素子1～素子3において、電流効率および初期輝度から95%の輝度となる時間（ $L T_{95}$ ）によって信頼性を評価した。表1に測定結果を示す。なお、表1では、電流効率および $L T_{95}$ を素子1の値で規格化している。

[0045] 表1からわかるように、素子1～素子3の電流効率はほぼ同じであるが、素子1、素子2、素子3の順で信頼性が向上した。特に、発光層全体に第2有機材料を添加し、電子ブロック層と接する第1領域の第2有機材料の濃度を高くした素子3において、信頼性の向上が顕著であった。

[0046]

[表1]

	素子1	素子2	素子3
電流効率 (a. u.)	1. 0 0	0. 9 8	1. 0 2
LT_{95} (a. u.)	1. 0 0	1. 1 7	1. 4 2

[0047] 以上、本実施形態に係る発光素子10によれば、発光層として機能する第2有機層15中に、電子ブロック層として機能する第1有機層14の第1有機材料を添加することにより、第2有機層15のキャリアバランスを調整することができる。また、第1有機層14と第2有機層15との界面における電子の蓄積を抑制し、また、第1有機層14と第2有機層15との界面から発光領域を遠ざけることにより、発光素子10の電流効率および信頼性が向上する。

[0048] <変形例1>

発光素子10の別の実施形態に係る発光素子10aの構成について、図2を参照して説明する。なお、以下では、発光素子10と同様の構成については説明を省略し、主に、発光素子10と異なる構成について説明する。

[0049] 図2は、本発明の一実施形態に係る発光素子10aの模式的断面図である。具体的には、図2は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子10aの一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

[0050] 発光素子10aは、一对の電極（第1電極11および第2電極19）と、第1有機層14と、第2有機層15aと、を含む。第1有機層14および第2有機層15aは、一对の電極（第1電極11および第2電極19）の間に設けられている。第2有機層15aは、第1有機層14に隣接して設けられている。第2有機層15aは、第1領域15a-1および第2領域15a-2を含み、第1領域15a-1は、第1有機層に接している。第1有機層1

4は第1有機材料を含み、第2有機層15aは第2有機材料を含む。

[0051] 発光素子10aでは、第1領域15a-1は第1有機材料を含むが、第2領域15a-2は第1有機材料を含まない。すなわち、発光素子10aにおいては、第1領域15a-1の第1有機材料の濃度および膜厚によって、第2有機層15a中のキャリアバランスを調整することができる。そのため、発光素子10aにおいても、電流効率および信頼性が向上する。

[0052] <変形例2>

発光素子10の別の実施形態に係る発光素子10bの構成について、図3を参照して説明する。なお、以下では、発光素子10と同様の構成については説明を省略し、主に、発光素子10と異なる構成について説明する。

[0053] 図3は、本発明の一実施形態に係る発光素子10bの模式的断面図である。具体的には、図3は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子10bの一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

[0054] 発光素子10bは、一对の電極（第1電極11および第2電極19）と、第1有機層14と、第2有機層15bと、を含む。第1有機層14および第2有機層15bは、一对の電極（第1電極11および第2電極19）の間に設けられている。第2有機層15bは、第1有機層14に隣接して設けられている。第2有機層15bは、第1領域15b-1、第2領域15b-2、および第3領域15b-3を含み、第1領域15b-1は、第1有機層に接している。第3領域15b-3は、第2領域15b-2よりも第1有機層14から離れている。第1有機層14は第1有機材料を含み、第2有機層15bは第2有機材料を含む。

[0055] 発光素子10bでは、第1領域15b-1、第2領域15b-2、および第3領域15b-3の各々が第1有機材料を含む。第1領域15b-1における第1有機材料の濃度は、第3領域15b-3における第1有機材料の濃度よりも大きい。また、第2領域15b-2における第1有機材料の濃度は、第3領域15b-3における第1有機材料の濃度よりも大きく、第1領域15b-1における第1有機材料の濃度よりも小さい。

[0056] 発光素子 10b においても、第 1 領域 15b-1、第 2 領域 15b-2、および第 3 領域 15b-3 の各々の第 1 有機材料の濃度および膜厚によって、第 2 有機層 15b 中のキャリアバランスを調整することができる。そのため、発光素子 10b においても、電流効率および信頼性が向上する。

[0057] なお、本実施形態では、第 1 領域 15b-1、第 2 領域 15b-2、および第 3 領域 15b-3 のように、第 2 有機層 15 における第 1 有機材料の濃度が 3 つに分離された構成について説明したが、第 1 有機材料の濃度の異なる領域は 3 つ以上であってもよい。また、第 2 有機層 15 における第 1 有機材料の濃度が、第 1 有機層 14 から第 3 有機層 16 に向かって小さくなるように連続的に設けられた構成とすることもできる。

[0058] <第 2 実施形態>

本発明の一実施形態に係る発光素子 20 の構成について、図 4 を参照して説明する。なお、以下では、発光素子 10 と同様の構成については説明を省略し、主に、発光素子 10 と異なる構成について説明する。

[0059] 図 4 は、本発明の一実施形態に係る発光素子 20 の模式的断面図である。具体的には、図 4 は、表示装置の表示領域に設けられた発光素子 20 の一部を拡大した断面図を示す。なお、表示装置の詳細については後述する。

[0060] 発光素子 20 は、一对の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）と、第 1 ユニット 20-1 と、第 2 ユニット 20-2 と、電荷発生層 23 と、を含む。第 1 ユニット 20-1、第 2 ユニット 20-2、および電荷発生層 23 は、一对の電極（第 1 電極 11 および第 2 電極 19）の間に設けられている。電荷発生層 23 は、第 1 ユニット 20-1 と第 2 ユニット 20-2 の間に設けられている。

[0061] 第 1 ユニット 20-1 は、第 1 有機層 24 および第 2 有機層 25 を含む。第 2 有機層 25 は、第 1 領域 25-1 および第 2 領域 25-2 を含み、第 1 領域 25-1 は、第 1 有機層 24 に接している。また、第 2 ユニット 20-2 は、第 1 有機層 26 および第 2 有機層 27 を含む。第 2 有機層 27 は、第 1 領域 27-1 および第 2 領域 27-2 を含み、第 1 領域 27-1 は、第 1

有機層 26 に接している。第 1 ユニット 20-1 の第 1 有機層 24 は第 1 有機材料を含み、第 2 有機層 25 は第 2 有機材料を含む。また、第 2 ユニットの第 1 有機層 26 は第 1 有機材料を含み、第 2 有機層 27 は第 2 有機材料を含む。第 1 有機材料および第 2 有機材料は、第 1 実施形態で説明したとおりであるが、第 1 ユニット 20-1 の第 1 有機材料と第 2 ユニット 20-2 の第 1 有機材料とは同じであってもよく、異なってもよい。同様に、第 1 ユニット 20-1 の第 2 有機材料と第 2 ユニット 20-2 の第 2 有機材料も同じであってもよく、異なってもよい。

[0062] 本実施形態においても、第 1 実施形態と同様に、第 1 ユニット 20-1 の第 2 有機層 25 は、第 1 有機層 24 の第 1 有機材料を含み、第 2 ユニット 20-2 の第 2 有機層 27 は、第 1 有機層 26 の第 1 有機材料を含む。

[0063] 以下では、本実施形態を理解しやすく説明するため、第 1 電極 11、第 1 有機層、第 2 有機層 15、第 3 有機層 16、および第 2 電極 19 が、それぞれ、陽極、電子ブロック層、発光層、正孔ブロック層、および陰極であるとして説明する。

[0064] 第 1 ユニット 20-1 は、さらに、正孔注入層 12 と、正孔輸送層 13 と、第 3 有機層 16（正孔ブロック層）と、電子輸送層 17 と、を含む。また、第 2 ユニット 20-2 は、さらに、正孔輸送層 13 と、第 3 有機層 16（正孔ブロック層）と、電子輸送層 17 と、電子注入層 18 と、を含む。但し、発光素子 20 の構成はこれに限られない。第 1 ユニット 20-1 および第 2 ユニット 20-2 に含まれる層は、必要に応じて適宜設けることができ、または省略することができる。

[0065] 電荷発生層 23 は、第 1 電極 11 と第 2 電極 19 との間に電圧を印加した場合に、第 1 ユニット 20-1 に電子を注入し、第 2 ユニット 20-2 に正孔を注入する機能を有する。電荷発生層 23 は、正孔輸送層 13 で使用可能な材料と同様もしくは類似する材料と電子受容体の混合物、または電子輸送層 17 で使用可能な材料と同様もしくは類似する材料と電子供与体の混合物を用いることができる。

[0066] 以上、本実施形態に係る発光素子 20 によれば、第 1 ユニット 20-1 および第 2 ユニット 20-2 から発光が得られるため、電流効率および信頼性の高い発光素子となる。発光層として機能する第 2 有機層 25 および 27 のそれぞれに、電子ブロック層として機能する第 1 有機層 24 および 26 の第 1 有機材料を添加することにより、第 2 有機層 25 および 27 のキャリアバランスを調整することができる。また、第 1 有機層 24 と第 2 有機層 25 との界面および第 1 有機層 26 と第 2 有機層 27 との界面における電子の蓄積を抑制し、また、第 1 有機層 14 と第 2 有機層 15 との界面および第 1 有機層 26 と第 2 有機層 27 との界面から発光領域を遠ざけることにより、発光素子 20 の電流効率および信頼性がさらに向上する。

[0067] <第 3 実施形態>

本発明の一実施形態に係る表示装置 100 の構成について、図 5 ～図 8 を参照して説明する。

[0068] 図 5 は、本発明の一実施形態に係る表示装置 100 の構成を示す平面図である。表示装置 100 は、基板 101 と、周辺領域 102 と、表示領域 103 と、を含む。

[0069] 表示領域 103 は基板 101 上に設けられている。表示領域 103 は、複数の画素 109 を含む。複数の画素 109 は、マトリクス状に配列されている。複数の画素 109 の配列数は任意である。例えば、行方向に m 個、列方向に n 個の画素 109 が配列される（m および n は整数）。複数の画素 109 の各々は、図 5 に図示されていないが、少なくとも選択トランジスタ、駆動トランジスタ、および発光素子を有する画素回路から構成される。

[0070] 周辺領域 102 は表示領域 103 を囲むように設けられている。なお、周辺領域 102 とは、表示領域 103 から基板 101 の端部までの領域をいう。言い換えれば、周辺領域 102 は、基板 101 上で表示領域 103 が設けられる以外の領域（すなわち、表示領域 103 の外側の領域）をいうものとする。周辺領域 102 は、駆動回路 104、端子 107 を含む。駆動回路 104 は、表示領域 103 を挟むように設けられている。また、周辺領域 10

2には、ドライバIC105が設けられていてもよい。ドライバIC105は、端子107と接続されている。端子107は、フレキシブルプリント回路基板108（FPC）と接続されている。

[0071] 駆動回路104は、画素109と接続される走査線と接続され、走査線駆動回路として機能する。また、ドライバIC105は、画素109と接続される信号線に接続され、信号線駆動回路が組み込まれている。なお、図5においては、ドライバIC105に、信号線駆動回路が組み込まれている構成を示すが、ドライバIC105とは別に、基板101上に信号線駆動回路が設けられていてもよい。

[0072] ドライバIC105は、ICチップのような形態で基板101上に配置されている。また、ドライバIC105は、図示しないが、フレキシブルプリント回路基板108上に設けてもよい。

[0073] 複数の画素109の各々には、ドライバIC105から信号線を介して、映像信号が与えられる。また、各画素109には、ドライバIC105から駆動回路104と、走査線とを介して各画素109を選択する信号が与えられる。これらの信号により、画素109が有するトランジスタを駆動させて、映像信号に応じた画面表示を行うことができる。

[0074] 図6は、本発明の一実施形態に係る表示装置100の構成を示す断面図である。具体的には、図6は、図5に示す表示装置100のA1-A2線に沿って切断した断面図である。

[0075] 図6に示すように、表示領域103は、複数の画素109R、109G、および109Bを有している。図6では、複数の画素109R、109G、および109Bのそれぞれが有する発光素子10R、10G、および10Bを、発光する色によって区別している。例えば、画素109Rの発光素子10Rは赤色を発光し、画素109Gの発光素子10Gは緑色を発光し、画素109Bの発光素子10Bは青色を発光する。

[0076] 基板101上には、下地層110を介して、トランジスタ120および容量素子130が設けられている。

- [0077] 基板 101 として、ガラス基板、石英基板、またはフレキシブル基板（ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、トリアセチルセルロース、環状オレフィン・コポリマー、シクロオレフィンポリマー、その他の可撓性を有する樹脂基板）を用いることができる。基板 101 が透光性を有する必要がない場合には、金属基板、セラミックス基板、または半導体基板を用いることも可能である。基板 101 として、フレキシブル基板を用いることにより、表示装置 100 を折り曲げることができる。
- [0078] 基板 101 上には、下地層 110 が設けられる。下地層 110 は、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸化アルミニウムなどの無機材料で構成される絶縁層である。下地層 110 は、単層構造であってもよく、例えば、酸化シリコン層と窒化シリコン層とを組み合わせた積層構造であってもよい。本実施形態では、下地層 110 として、窒化シリコン層 111、酸化シリコン層 112、および窒化シリコン層 113 の三層構造で設ける場合について示す。この構成は、基板 101 との密着性や、後述するトランジスタ 120 に対するガスバリア性を考慮して適宜決定すれば良い。
- [0079] トランジスタ 120 は、半導体層 114、ゲート絶縁膜 115、ゲート電極 117、ソース電極 122、またはドレイン電極 123 を有する。トランジスタ 120 は、Nch 型トランジスタであってもよいし、Pch 型トランジスタであってもよい。本実施形態では、トランジスタ 120 は、Nch 型トランジスタを用いる場合について説明する。
- [0080] 半導体層 114 は、アモルファス、ポリシリコン、または酸化物半導体を用いることができる。本実施形態では、ポリシリコンを用いる場合について説明する。Nch 型トランジスタでは、半導体層 114 に、チャネル領域 114a と、高濃度不純物領域 114d、114e（ソース領域またはドレイン領域）との間に、低濃度不純物領域 114b、114c を設けた構造を有する。
- [0081] ゲート絶縁膜 115 として、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸化アルミニウムなどの無機材料で構成される絶縁層を用いることができる。ゲー

ト電極 1 1 7 としては、銅、モリブデン、タンタル、タングステン、アルミニウムなどの金属材料で構成される導電層を用いることができる。ソース電極 1 2 2 またはドレイン電極 1 2 3 の各々は、銅、チタン、モリブデン、またはアルミニウムなどの金属材料で構成される導電層を用いることができる。

[0082] 容量素子 1 3 0 は、ゲート絶縁膜 1 1 5 を間に挟んで、一对の電極で形成される。容量素子 1 3 0 の一方の電極として、半導体層 1 1 4 の高濃度不純物領域 1 1 4 d を用い、他方の電極として、導電層 1 1 8 を用いる。導電層 1 1 8 は、ゲート電極と同じ膜から形成される。

[0083] トランジスタ 1 2 0 および容量素子 1 3 0 を覆うように、層間絶縁層 1 1 9 が設けられている。層間絶縁層 1 1 9 は、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸化アルミニウムなどの無機材料で構成される絶縁層である。また、層間絶縁層 1 1 9 上には、ソース電極 1 2 2 またはドレイン電極 1 2 3 が設けられている。ソース電極 1 2 2 またはドレイン電極 1 2 3 は、ゲート絶縁膜 1 1 5 および層間絶縁層 1 1 9 に設けられたコンタクトホールを介して、半導体層 1 1 4（高濃度不純物領域 1 1 4 d、1 1 4 e）と接続される。

[0084] 層間絶縁層 1 1 9 上に、平坦化膜 1 2 1 が設けられる。平坦化膜 1 2 1 は、有機樹脂材料を含む。有機樹脂材料としては、例えば、ポリイミド、ポリアミド、アクリル、またはエポキシなどの有機樹脂材料を用いることができる。これらの材料は、溶液塗布法により膜形成が可能であり、平坦化効果が高いという特長がある。平坦化膜 1 2 1 は、ソース電極 1 2 2 またはドレイン電極 1 2 3 の一部を露出させるコンタクトホールを有する。コンタクトホールは、後述する第 1 電極 1 1 とソース電極 1 2 2 またはドレイン電極 1 2 3 とを電氣的に接続するために設けられる。

[0085] 平坦化膜 1 2 1 に設けられたコンタクトホールには、透明導電層 1 2 5 が設けられる。透明導電層 1 2 5 は、平坦化膜 1 2 1 が有するコンタクトホールに重畳し、コンタクトホールの底面で露出されたソース電極 1 2 2 またはドレイン電極 1 2 3 と電氣的に接続する。透明導電層 1 2 5 として、酸化イ

ンジウム系透明導電層（例えば、ITO）や酸化亜鉛系透明導電層（例えば、IZO、ZnO）を用いることができる。また、平坦化膜121上には、透明導電層124が設けられる。透明導電層125と透明導電層124とは、同じ材料により形成される。

[0086] また、透明導電層125上には、絶縁層211が設けられる。絶縁層211として、窒化シリコン層などを使用することが好ましい。絶縁層211には、ソース電極122またはドレイン電極123と、透明導電層125とが重畳する領域において、コンタクトホールが形成されている。

[0087] また、絶縁層211上には、第1電極11が設けられている。第1電極11は、絶縁層211に設けられたコンタクトホールを介して、透明導電層125と接続されている。これにより、第1電極11は、ソース電極またはドレイン電極123と電氣的に接続される。また、第1電極11と、絶縁層211と、透明導電層124とにより、容量素子130が構成される。

[0088] 絶縁層211上には、発光素子10R、10G、および10Bが設けられている。発光素子10R、10G、および10Bは、それぞれ、第1電極11、第1機能層21、第2機能層22、および第2電極19を有している。また、発光素子10R、10G、および10Bは、それぞれ、発光する色に応じて、第2有機層15R、15G、および15Bを有している。また、発光素子10R、10G、および10Bをそれぞれ分離するためのバンク213が設けられている。発光素子10R、10G、および10Bの各々の構成は、第1実施形態で説明したとおりである。

[0089] 発光素子10R、10G、および10B上には、封止膜220が設けられている。封止膜220は、発光素子10R、10G、および10Bに水分が侵入することを防止するために設けられる。封止膜220として、酸化シリコン、窒化シリコン、もしくは酸化アルミニウムなどの無機材料、またはポリイミド、ポリアミド、アクリル、もしくはエポキシなどの有機樹脂材料を用いることができる。図6では、封止膜220として、無機絶縁層221、有機絶縁層222、および無機絶縁層223を用いる構成を示している。

[0090] 図示しないが、封止膜 220 上には、偏光板が設けられていてもよい。偏光板は、封止膜 220 上に、粘着材を用いて貼りつけられていてもよい。または、封止膜 220 上に粘着材を用いて基板が貼り付けられ、さらに基板上に粘着材を介して偏光板が貼り付けられていてもよい。

[0091] 次に、本実施形態に係る表示装置 100 の画素が有する発光素子の構成について図 7 および図 8 を参照して説明する。

[0092] 図 7 は、本発明の一実施形態に係る表示装置 100 の表示領域 103 にマトリクス状に配列された複数の画素 109R、109G、および 109B のレイアウトを示す平面図である。また、図 8 は、本発明の一実施形態に係る表示装置 100 の表示領域の断面図である。具体的には、図 8 は、図 7 に示す B1-B2 線に沿って切断したときの断面図である。図 8 に示すように、画素 109R、109G、および 109B に設けられる発光素子 10R、10G、および 10B の断面を示している。なお、図 8 では、発光素子 10R、10G、および 10B の各々に接続されるトランジスタ 120 の断面については図示を省略しているが、その態様については図 6 の説明と同様である。

[0093] 図 7 に示すように、表示領域 103 においては、複数の画素 109R、109G、および 109B がマトリクス状に配置されている。図 8 では、画素 109R、109G、および 109B を構成する一部の層を示している。また、図 8 では、第 1 電極 11 と、バンク 213 の開口部 214 と、第 2 有機層 15R、15G、および 15B を示している。複数の第 1 電極 11 は、マトリクス状に配置されている。また、第 2 有機層 15R、15G、および 15B は、それぞれ、行方向に隣接する第 1 電極 11の間では不連続であり、列方向に隣接する第 1 電極 11の間では連続している。

[0094] 以上、本実施形態に係る表示装置 100 によれば、各画素 109 が発光素子 10 を含むため、表示装置 100 の電流効率および信頼性が向上する。

[0095] 本発明の実施形態として上述した各実施形態は、相互に矛盾しない限りにおいて、適宜組み合わせて実施することができる。また、各実施形態を基に

して、当業者が適宜構成要素の追加、削除もしくは設計変更を行ったもの、または、工程の追加、省略もしくは条件変更を行ったものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。

[0096] 上述した各実施形態の態様によりもたらされる作用効果とは異なる他の作用効果であっても、本明細書の記載から明らかなもの、または、当業者において容易に予測し得るものについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。

符号の説明

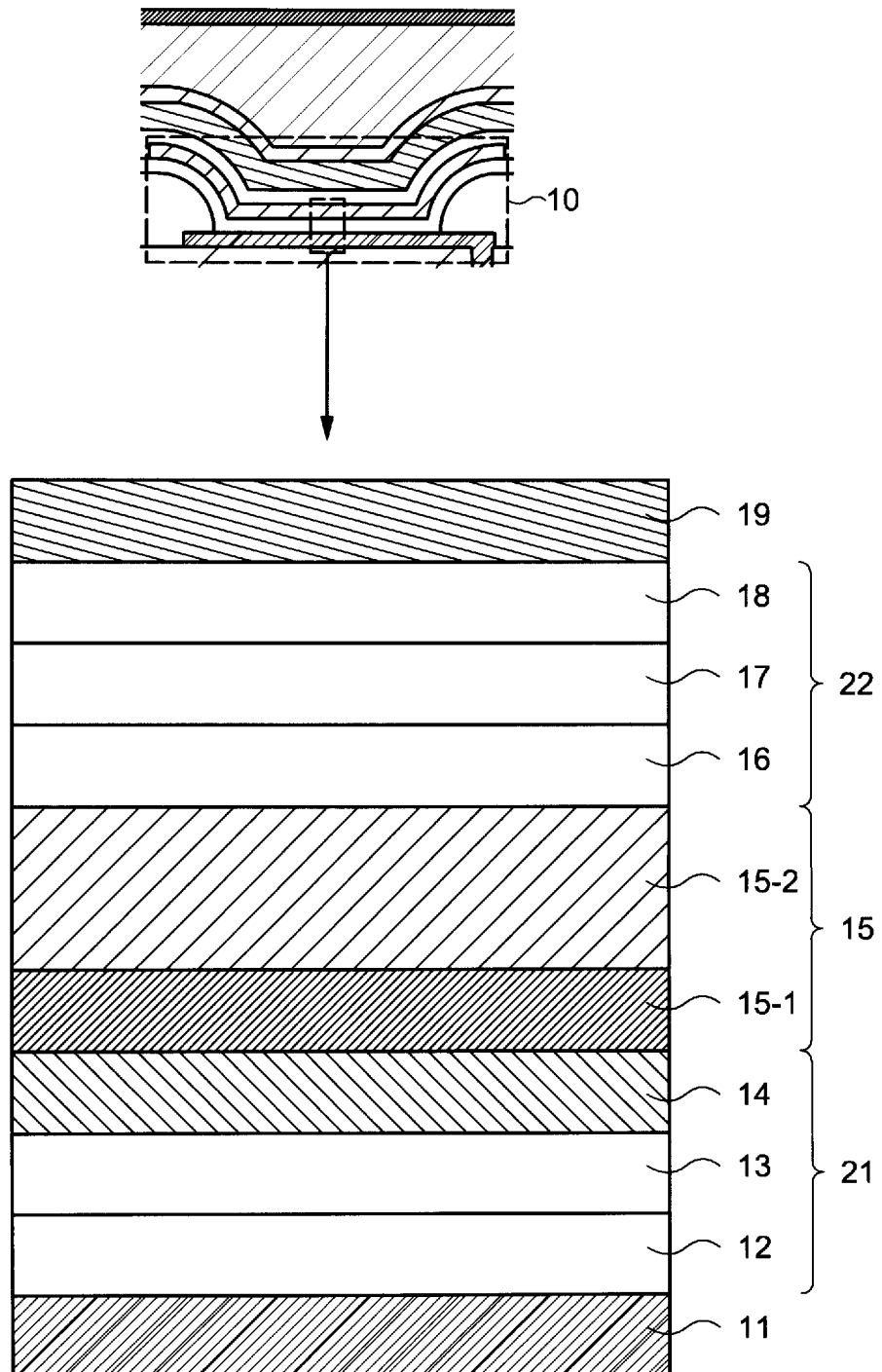
[0097] 10、10a、10b、10B、10G、10R、20：発光素子、 11：第1電極、 12：正孔注入層、 13：正孔輸送層、 14、24、26：第1有機層、 15、15a、15b、15G、15R、25、27：第2有機層、 15-1、15a-1、15b-1、25-1、27-1：第1領域、 15-2、15a-2、15b-2、25-2、27-2：第2領域、 15b-3：第3領域、 16：第3有機層、 17：電子輸送層、 18：電子注入層、 19：第2電極、 20-1：第1ユニット、 20-2：第2ユニット、 21：第1機能層、 22：第2機能層、 23：電荷発生層、 100：表示装置、 101：基板、 102：周辺領域、 103：表示領域、 104：駆動回路、 107：端子、 108：フレキシブルプリント回路基板、 109、109B、109G、109R：画素、 110：下地層、 111、113：窒化シリコン層、 112：酸化シリコン層、 114：半導体層、 114a：チャネル領域、 114b、114c：低濃度不純物領域、 114d、114e：高濃度不純物領域、 115：ゲート絶縁膜、 117：ゲート電極、 118：導電層、 119：層間絶縁層、 120：トランジスタ、 121：平坦化膜、 122：ソース電極、 123：ドレイン電極、 124、125：透明導電層、 130：容量素子、 211：絶縁層、 213：バンク、 214：開口部、 220：封止膜、 221、223：無機絶縁層、 222：有機絶縁層

請求の範囲

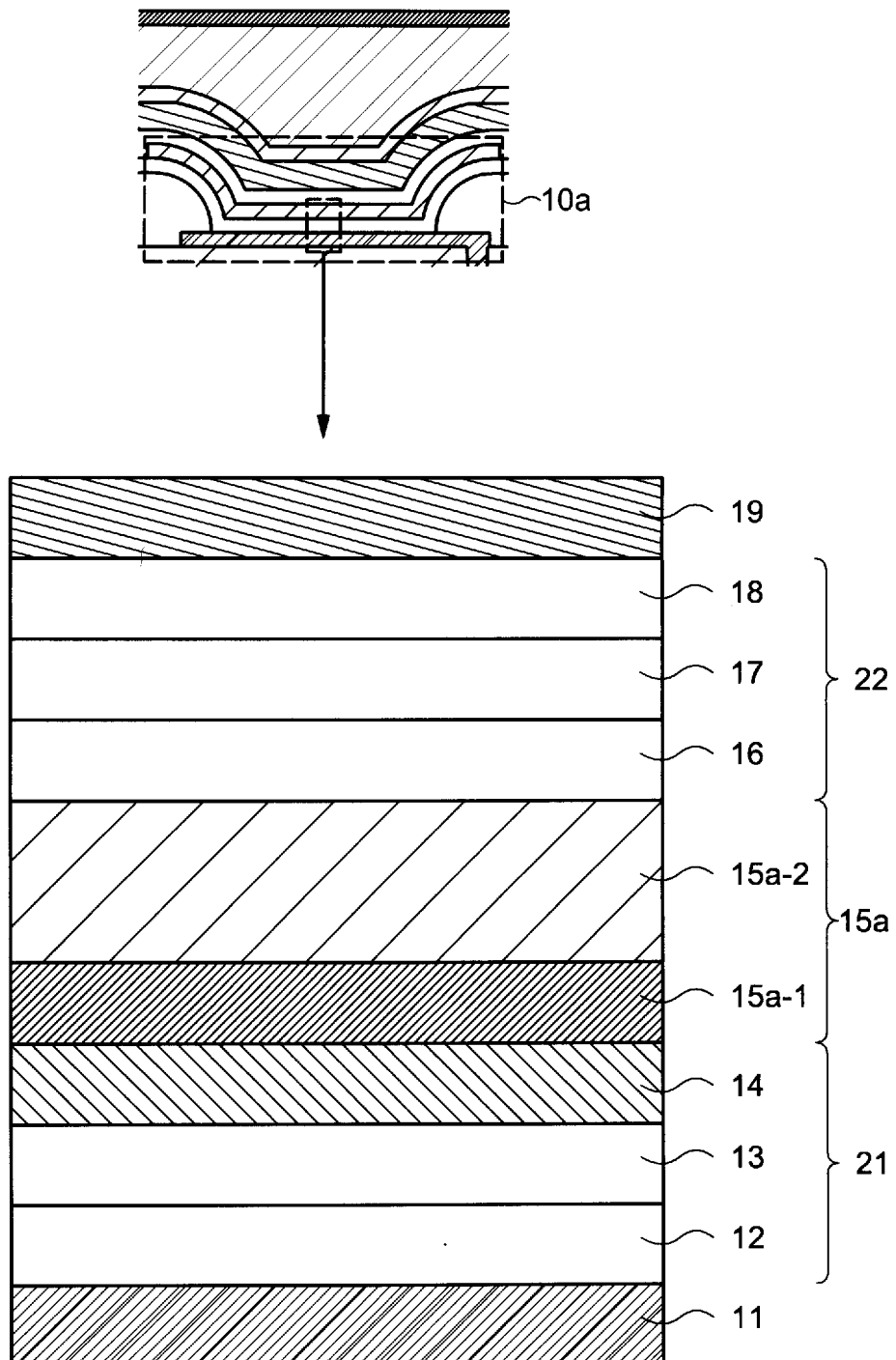
- [請求項1] 一対の電極と、
前記一対の電極の間に、第1有機層および前記第1有機層に隣接する第2有機層と、を含み、
前記第1有機層は、第1有機材料を含み、
前記第2有機層は、第2有機材料を含み、
前記第2有機層は、第1領域および第2領域を含み、
前記第1領域は、前記第1有機層と接し、前記第1有機材料を含む発光素子。
- [請求項2] 前記第1有機材料は、電子輸送性よりも正孔輸送性が高く、
前記第1有機層の最低空軌道（LUMO）準位の絶対値は、前記第2有機層の最低空軌道（LUMO）準位の絶対値よりも小さい請求項1に記載の発光素子。
- [請求項3] 前記第1有機層の最低空軌道（LUMO）準位と前記第2有機層の最低空軌道（LUMO）準位との差の絶対値は、 0.2 eV 以上である請求項2に記載の発光素子。
- [請求項4] 前記第2有機材料は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高い化合物である請求項1に記載の発光素子。
- [請求項5] 前記第1領域の膜厚は、前記第2有機層の膜厚の 0% よりも大きく、かつ、 40% 以下である請求項1に記載の発光素子。
- [請求項6] 前記第1領域における前記第1有機材料の濃度は、前記第2有機材料に対して $20\text{ 重量}\%$ 以下である請求項1に記載の発光素子。
- [請求項7] 前記第2領域は、前記第1有機材料を含まない請求項1に記載の発光素子。
- [請求項8] 前記第2領域は、前記第1有機材料を含み、
前記第2領域における前記第1有機材料の濃度は、前記第1領域における前記第1有機材料の濃度よりも小さい請求項1に記載の発光素子。

- [請求項9] 前記第2有機層は、さらに、前記第2領域よりも前記1有機層から離れた第3領域を含み、
前記第3領域は、前記第1有機材料を含み、
前記第3領域における前記第1有機材料の濃度は、前記第2領域における前記第1有機材料の濃度よりも小さい請求項8に記載の発光素子。
- [請求項10] さらに、前記一对の電極の間に、前記第2有機層に隣接する第3有機層を含み、
前記第3有機層は、正孔輸送性よりも電子輸送性が高い第3有機材料を含み、
前記第3有機層の最高被占軌道（HOMO）準位の絶対値は、前記第2有機層の最高被占軌道（HOMO）準位の絶対値よりも大きい請求項1に記載の発光素子。
- [請求項11] 前記第3有機層の最高被占軌道（HOMO）準位と前記第2有機層の最高被占軌道（HOMO）準位との差の絶対値は、 0.2 eV 以上である請求項10に記載の発光素子。
- [請求項12] 前記第3有機層は、前記第2領域と接する請求項10に記載の発光素子。
- [請求項13] 前記第2有機層は、さらに、前記第2領域よりも前記1有機層から離れ、前記第3有機層と接する第3領域を含み、
前記第3領域は、前記第1有機材料を含み、
前記第3領域における前記第1有機材料の濃度は、前記第2領域における前記第1有機材料の濃度よりも小さい請求項10に記載の発光素子。
- [請求項14] 前記第2有機層は、発光層である請求項1に記載の発光素子。
- [請求項15] 請求項1乃至請求項14のいずれか一項に記載の発光素子を画素に含む表示装置。

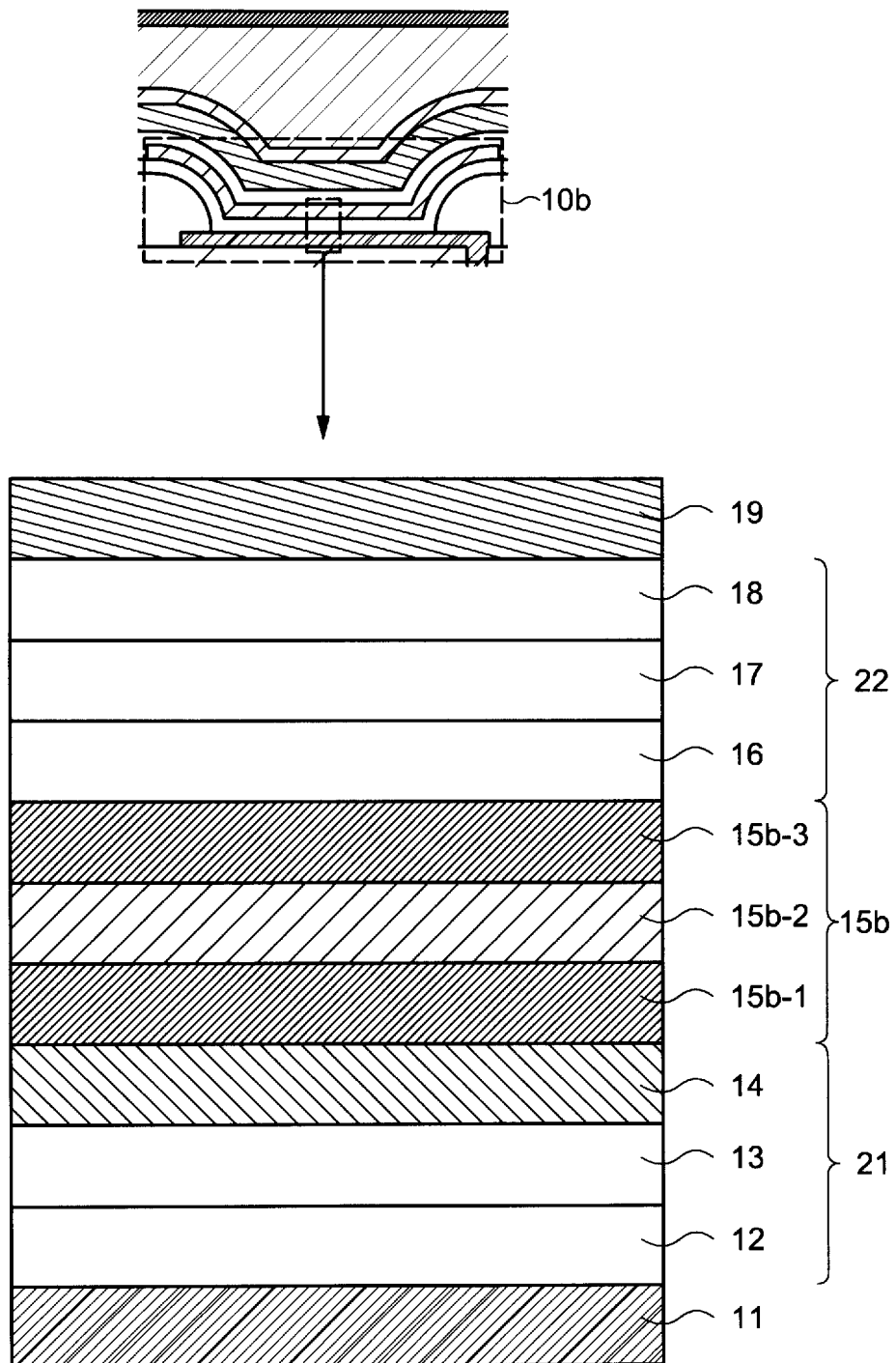
[図1]



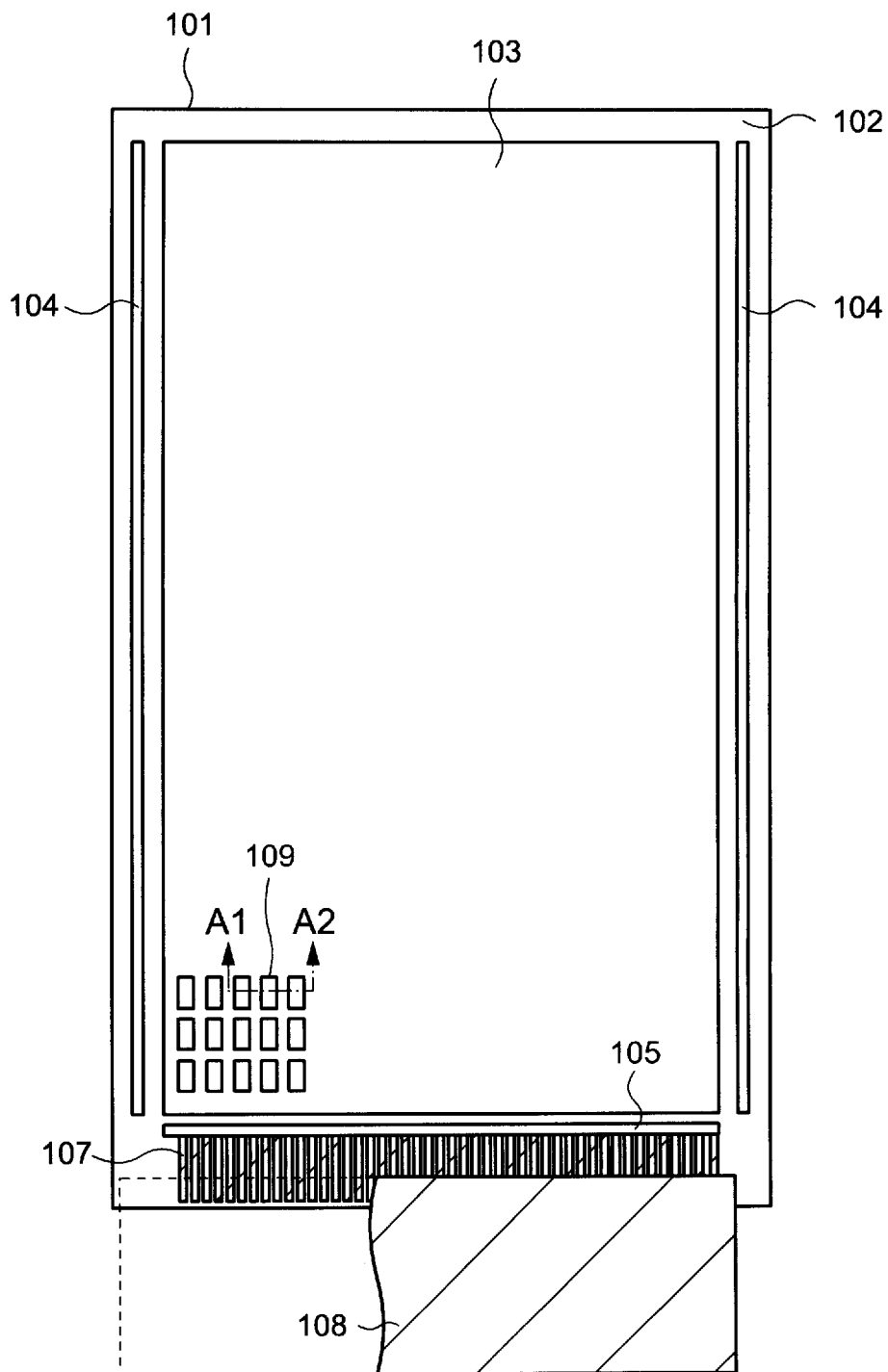
[図2]



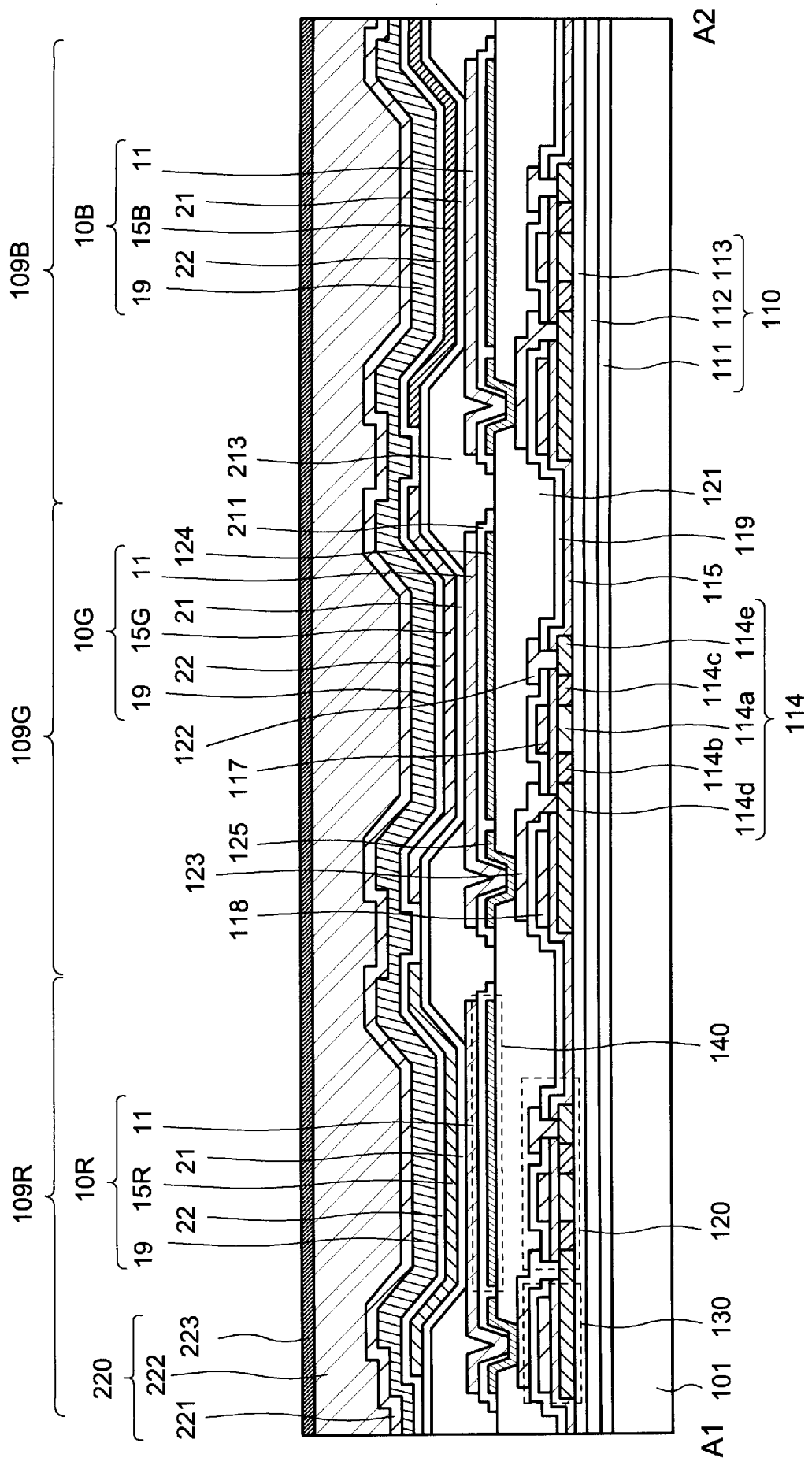
[図3]



[図5]

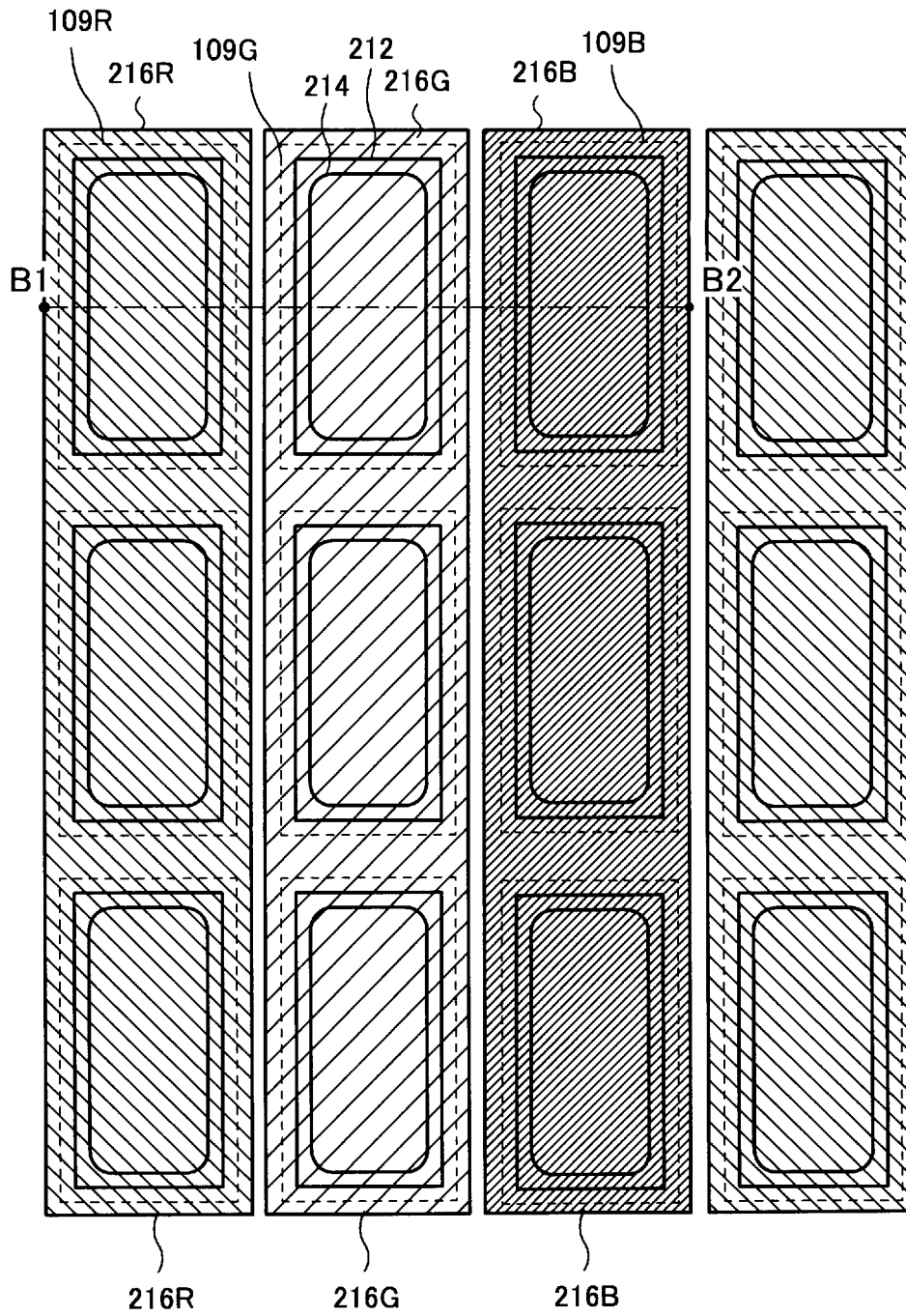
100

[図6]

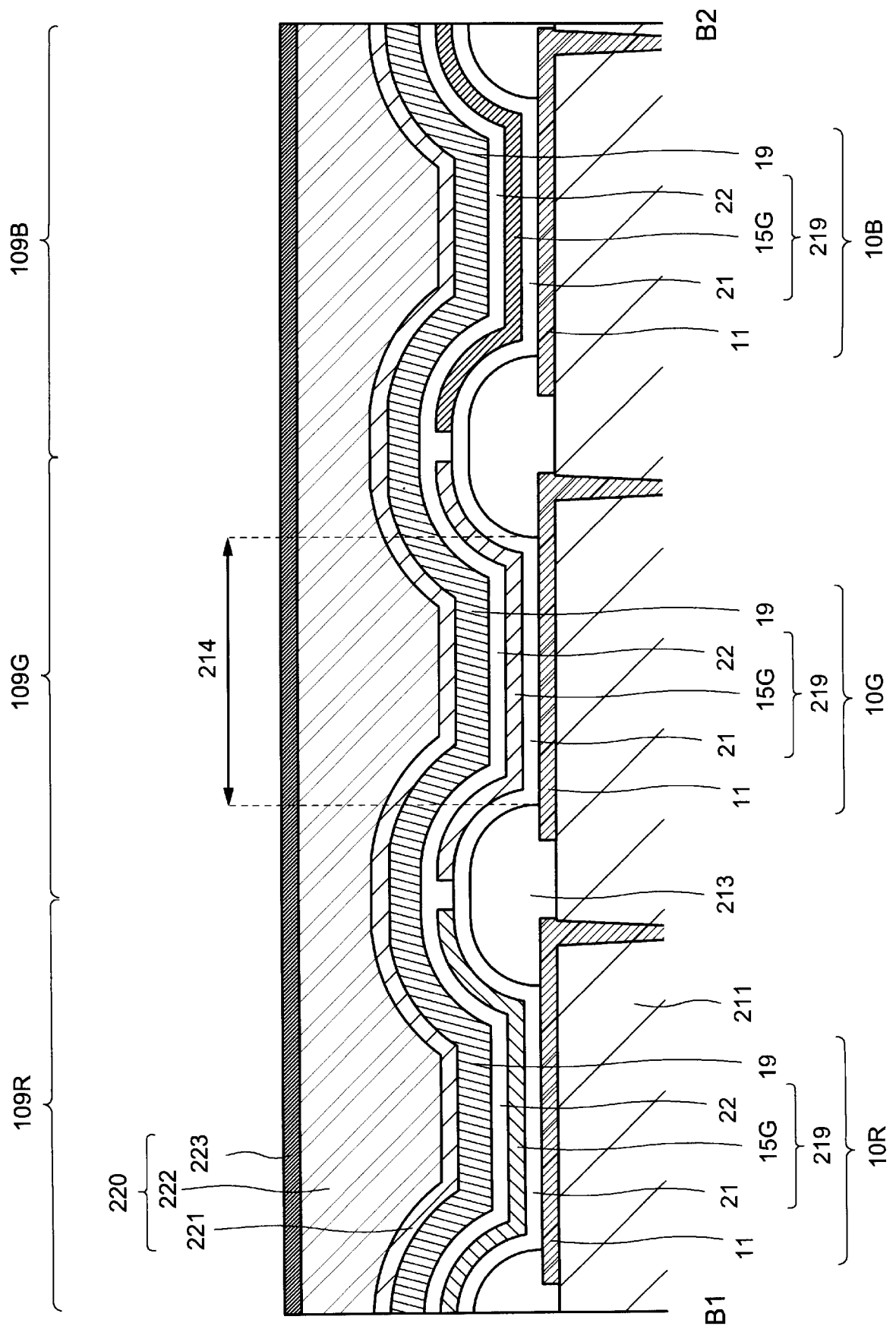


[図7]

103



【図8】



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2021/008200

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. G09F9/30 (2006.01) i, H01L27/32 (2006.01) i, H01L51/50 (2006.01) i
FI: H05B33/14 B, H01L27/32, H05B33/22 D, H05B33/22 B, G09F9/30 365

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. G09F9/30, H01L27/32, H01L51/50

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2021

Registered utility model specifications of Japan 1996-2021

Published registered utility model applications of Japan 1994-2021

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	JP 2019-169618 A (TDK CORP.) 03 October 2019, paragraphs [0002], [0009], [0085]-[0089], [0096], [0110]	1-4, 10-12, 14-15 5-9, 13
X A	JP 2014-160850 A (SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.) 04 September 2014, paragraphs [0001], [0048], [0055], [0061], [0111]-[0113], fig. 19	1, 6, 14-15 2-5, 7-13
X A	JP 2013-102202 A (SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.) 23 May 2013, paragraphs [0013], [0014], [0018], [0023], [0035], [0044], [0051], [0056], [0065], [0074], [0079], [0104]	1, 14-15 2-13



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
30.03.2021

Date of mailing of the international search report
13.04.2021

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2021/008200

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2014-13945 A (UDC IRELAND LTD.) 23 January 2014, paragraphs [0012], [0020], [0021]	1-15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2021/008200

Patent Documents referred to in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2019-169618 A	03.10.2019	(Family: none)	
JP 2014-160850 A	04.09.2014	US 2016/0087236 A1 paragraphs [0003], [0051], [0057], [0063], [0149]- [0151], fig. 19 EP 1220339 A2 paragraphs [0001], [0048], [0054], [0060], [0109]- [0111], fig. 19 TW 545080 B KR 10-2002-0055418 A CN 1362747 A SG 93298 A MY 130464 A	
JP 2013-102202 A	23.05.2013	JP 2009-94500 A US 2009/0079326 A1 paragraphs [0014], [0015], [0019], [0024], [0049], [0058], [0065], [0070], [0079], [0088], [0093], [0118]	
JP 2014-13945 A	23.01.2014	(Family: none)	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） G09F 9/30(2006.01)i; H01L 27/32(2006.01)i; H01L 51/50(2006.01)i FI: H05B33/14 B; H01L27/32; H05B33/22 D; H05B33/22 B; G09F9/30 365										
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） G09F9/30; H01L27/32; H01L51/50 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2021年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2021年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2021年</td> </tr> </table> 国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）			日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2021年	日本国実用新案登録公報	1996-2021年	日本国登録実用新案公報	1994-2021年
日本国実用新案公報	1922-1996年									
日本国公開実用新案公報	1971-2021年									
日本国実用新案登録公報	1996-2021年									
日本国登録実用新案公報	1994-2021年									
C. 関連すると認められる文献										
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号								
X	JP 2019-169618 A (TDK株式会社) 03.10.2019 (2019-10-03) [0002][0009][0085]-[0089][0096][0110]	1-4, 10-12, 14-15								
A		5-9, 13								
X	JP 2014-160850 A (株式会社半導体エネルギー研究所) 04.09.2014 (2014-09-04) [0001][0048][0055][0061][0111]-[0113], 図19	1, 6, 14-15								
A		2-5, 7-13								
X	JP 2013-102202 A (株式会社半導体エネルギー研究所) 23.05.2013 (2013-05-23) [0013]-[0014][0018][0023][0035][0044][0051][0056][0065][0074][0079] [0104]	1, 14-15								
A		2-13								
A	JP 2014-13945 A (ユー・ディー・シー アイルランド リミテッド) 23.01.2014 (2014-01-23) [0012][0020]-[0021]	1-15								
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。										
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献										
国際調査を完了した日 30.03.2021		国際調査報告の発送日 13.04.2021								
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 藤岡 善行 20 1948 電話番号 03-3581-1101 内線 3231								

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2021/008200

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2019-169618	A	03.10.2019	(ファミリーなし)	
JP	2014-160850	A	04.09.2014	US 2016/0087236 A1 [0003][0051][0057][0063] [0149]-[0151], 図19 EP 1220339 A2 [0001][0048][0054][0060] [0109]-[0111], 図19 TW 545080 B KR 10-2002-0055418 A CN 1362747 A SG 93298 A MY 130464 A	
JP	2013-102202	A	23.05.2013	JP 2009-94500 A US 2009/0079326 A1 [0014]-[0015][0019][0024] [0049][0058][0065][0070] [0079][0088][0093][0118]	
JP	2014-13945	A	23.01.2014	(ファミリーなし)	